ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ

№ 3/520 от 31 марта 2010 года

<u>О конкурсах в рамках ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и</u> радиоэлектроники" на 2008-2015 годы

<u>Мероприятие 60</u> "Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники

<u>Подробная информация о конкурсах представлена на сайте: http://www.fasi.gov.ru</u> в разделе «Федеральные целевые программы» http://www.fasi.gov.ru/fcp/electro/konkurs2010/m60/2041/

Для участия в данных конкурсах необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная регистрация заявки в отделе НТПГ (И-310, 362-77-78).

Вскрытие конвертов - 19 апреля 2010 г. в 10-00по адресу: Москва, Брюсов пер., д.11,. Рассмотрение заявок - **23 апреля 2010 г** Подведение итогов конкурса: **29 апреля 2010** г

Срок выполнения работы: май 2010 года – 15 ноября 2011 года.

ЛОТ	Шифр лота	ты: маи 2010 года – 15 нояоря 2011 года. Тема исследований	Цена контракта
1	2010-ЭКБР-60-004	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: встроенных интегральных антенных элементов для диапазонов частот 5 ГГц, 10-12 ГГц	10,0 млн. рублей
2	2010-ЭКБР-60-005	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов, включая биосенсоры	11,0 млн. рублей
3	2010-ЭКБР-60-006	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: сенсоров на основе магнито- электрических материалов	11,0 млн. рублей
4	2010-ЭКБР-60-007	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов, включая сенсоры с применением наноструктур (термокаталитические газовые сенсоры)	11,0 млн. рублей
5	2010-ЭКБР-60-008	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: систем на кристалле (16 разрядный микропроцессор с интегрированной флеш-памятью)	10,0 млн. рублей
6	2010-ЭКБР-60-009	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: систем на кристалле, в том числе в гетероинтеграции сенсорных и исполнительных элементов методом беспроводной сборки с применением технологии матричных жестких выводов	10,0 млн. рублей
7	2010-ЭКБР-60-010	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: систем на кристалле (для устройств дистанционного управления)	10,0 млн. рублей
8	2010-ЭКБР-60-011	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов (усилителей на мощных полевых транзисторах, выполненных на основе наноструктур)	11,0 млн. рублей
9	2010-ЭКБР-60-012	Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов (преобразователя частота-напряжение на основе эффекта Джозефсона)	10,0 млн. рублей

Helwood

Проректор по научной работе

Н.В. Скибицкий